

## عنوان مقاله:

اثر میدان مغناطیسی ثابت در جهت جریان سیال بر ویسکوزیته نانوسیال

## محل انتشار:

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

## نویسندگان:

حامد کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

نسرین اعتصامی - عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محسن نصرافهانی - عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

## خلاصه مقاله:

ویسکوزیته نانوسیال مغناطیسی اتیلن گلايکول-4-Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> تحت میدان مغناطیسی ثابت، موازی و در جهت جریان نانوسیال بهطور آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش شدت میدان مغناطیسی ویسکوزیته نانوسیال کاهش مییابد. همچنین آزمایشات نشان داد افزایش زمان قرارگیری نانوسیال در معرض میدان مغناطیسی تأثیر کاهش ویسکوزیته نانوسیال را بیشتر میکند.

## کلمات کلیدی:

ویسکوزیته نانوسیال مغناطیسی، میدان مغناطیسی، ویسکومتر لوله موئین

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/172233>

